

智能手机应用的输入/输出特性及其对 eMMC

nputer

设计的影响

第 11 届 IEEE 工作负载特性国际研讨会(IISWC),美国亚特兰大,2015 年 Deng Zhoul、Wen Panl

导言

人们对智能手机应用程序的块级 I/O 特性及其对 eMMC 设计的影 响还知之甚少。在这项研究中,我们收集并分析了 Nexus 5 智能 手机上 18 个常见应用程序(如电子邮件和 Twitter)的块级 I/O 跟踪。我们观察到了一些 I/O 特性,并从中得出了 eMMC 设计的 若干启示。接下来,我们将进行案例研究,演示如何应用这些影 响来优化 eMMC 设计。受这两种影响的启发,我们提出了一种 混合页面大小(HPS)的 eMMC。实验结果表明,HPS 方案可将 平均响应时间缩短 86%,同时将空间利用率提高 24.2%。

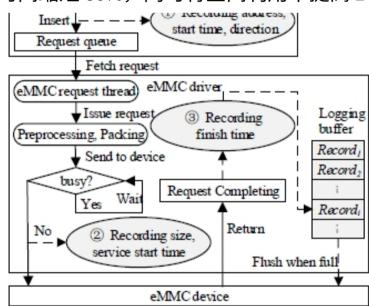


图 1 BIOTracer 的结构。

痕迹系列

CallIn, CallOut (1 hour): Mimicking a phone interview including answering, talking, listening, and hanging out. CameraVideo, AngryBrid, GoogleMaps (0.5 - 1 hour): Recording a video, playing games, driving navigating. Facebook, Tiwtter, Amazon, Email, Messaging (10 - 20 *minutes*): Viewing comments, searching people or items, viewing pictures, and composing replies. **WebBrowsing, Youtube, Radio, Music** (1 - 1.5 hours):

Reading news, watching online videos, listening radio, and listening music.

Movie, Installing (10 minutes): Watching locally stored movie, installing game applications via WIFI connection.

和源嘉分析结果迭戈州立大学。加利福尼亚州圣影响实例

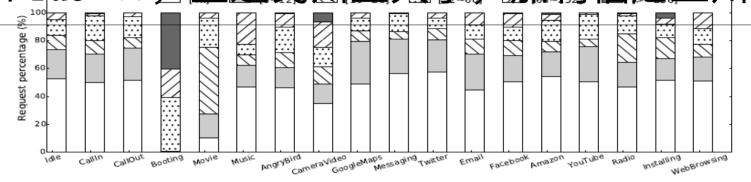


图 3 申请量分布

特点: 在大多数应用程序中, 小规模请求占请求总数的 很大比例。在 18 个跟踪中的 15 个

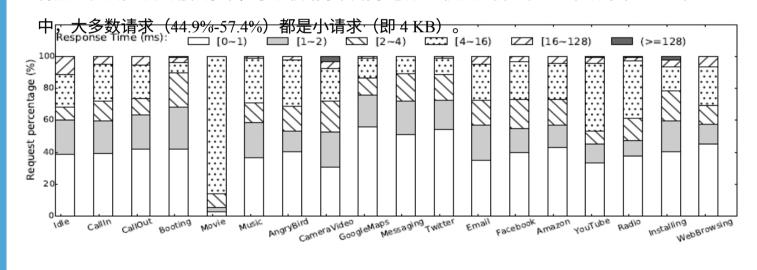


图 4 响应时间分布

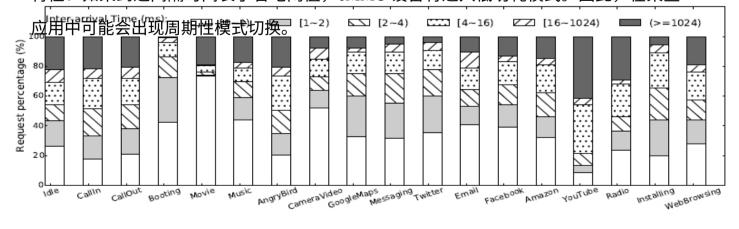


图 5 到达时间间隔分布

特点:大多数应用程序的平均请求到达时间较长。18个应用程序中有13个的平均请求到 达时间至少为 200 毫秒。在 18 个跟踪中,有 10 个超过 20% 的请求到达时间大于 16 毫秒

启示 1: 在大多数应用程序中,小规模请求占请求总数的很大比例 。在 18 次跟踪中有 15 次大部分请求(44.9%-57.4%)是小请求(即 4 KB)。启示 5: 特征 2 显示,在 18 次跟踪中有 15 次 (44.9%-57.4%)的大多数请求是小型单页(4 KB)请求。这意味着,快速 处理大量小型请求可提高 eMMC 设备的整体性能。更好地满足这些 小请求的一个可行方法是使用 SLC 闪存,它的读/写性能优于 MLC 闪存(见表 4)。不过,SLC 比 MLC 昂贵得多。幸运的是,MLC 闪存单元可以在 SLC 模式下工作,有选择地使用其快速页,从而获 得类似 SLC 的性能[2]。因此,性能的提升是以 50%的容量损失为代 价的。

启示 2: eMMC 中的 FTL 需要根据智能手机的 I/O 特性(特性 3 和 6) 进行调整。我们发现,18 项跟踪中有 13 项的平均请求到达间隔 时间超过 200 毫秒,这足够长的时间来完成垃圾收集过程。因此, 应重新设计 FTL 的垃圾回收机制,以便在执行这些非数据密集型应 用时启动垃圾回收。这样,用户就不会感觉到垃圾收集导致的性能 结论

为了解智能手机应用程序的 I/O 模式,我们开发了一款名为 BIOtracer 的 I/O 监 控工具,并将其集成到 Nexus 上的安卓内核 3.4 中。

5.接下来,我们对 25 条轨迹进行综合分析。我们观察到六种 I/O 特性。然后, 根据这些特征得出 eMMC 设计的 5 个影响。最后,我们进行了一个案例研究 ,演示如何应用这些影响来优化 eMMC 设计。

鸣谢

这项工作得到了美国国家科学基金会的资助(GrantCNS-1320738)。

参考资料

[1] H. Kim 和 D. Shin。优化安卓智能手机的存储性能。第7 论文集》、第1页。



